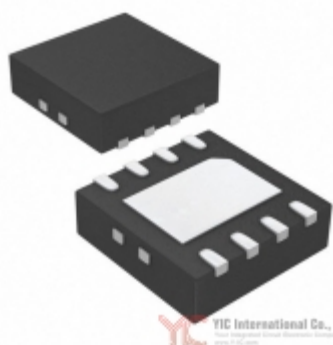





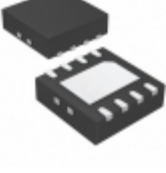



	<b>ZXMN3AM832TA</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	ZXMN3AM832TA
	<b>Hersteller / Marke:</b>	Diodes Incorporated
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET 2N-CH 30V 2.9A 8MLP
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">ZXMN3AM832TA.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 71893 pcs Stock Available.
	<b>Lieferrn von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	ZXMN3AM832TA
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 2.9A 8MLP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	71893 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1.13W
Verpackung / Gehäuse	8-VDFN Exposed Pad
Supplier Device-Gehäuse	8-MLP (3x2)
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.9A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	120 mOhm @ 2.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA (Min)
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	3.9nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	190pF @ 25V
Verpackung	Cut Tape (CT)



ZXMN3AM832TA ist neu im Original, Suche ZXMN3AM832TA Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie ZXMN3AM832TA Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage ZXMN3AM832TA: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>ZXMN3A14F</b> ZETEX ZXMN3A14F ZETEX</p>	 <p><b>ZXMN3A06N8TA</b> Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 30V 8SOIC</p>	 <p><b>ZXMN3A14FTA</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 3.2A SOT23-3</p>	 <p><b>ZXMN3A14FTC</b> ZETEX/DIODES ZXMN3A14FTC ZETEX/DIODES</p>
 <p><b>ZXMN3AMCTA</b> Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 30V 2.9A DFN</p>	 <p><b>ZXMN3B01F</b> Diodes Incorporated ZXMN3B01F DIODES</p>	 <p><b>ZXMN3B04N8</b> Diodes Incorporated ZXMN3B04N8 DIODES</p>	 <p><b>ZXMN3A14FQTA</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 3.9A SOT23-3</p>

### heiße Teile

Mehr

 ZXMN2F34FHHTA	 ZXMN2F34MATA	 ZXMN3A01E6TA	 ZXMN3A01F	 ZXMN3A01FTA
 ZXMN3A01FTC	 ZXMN3A01ZTA	 ZXMN3A02N8	 ZXMN3A02N8TA	 ZXMN3A02X8TA
 ZXMN3A03E6	 ZXMN3A03E6TA	 ZXMN3A04DN8	 ZXMN3A04DN8TA	 ZXMN3A04DN8TC
 ZXMN3A04K	 ZXMN3A04KTC	 ZXMN3A06D	 ZXMN3A06DN8	 ZXMN3A06DN8TA
 ZXMN3A06DN8TC	 ZXMN3A14F	 ZXMN3A14FQTA	 ZXMN3A14FTA	 ZXMN3A14FTC
 ZXMN3B01FTA	 ZXMN3B01FTC	 ZXMN3B04N8	 ZXMN3B04N8TA	 ZXMN3B04N8TC
 ZXMN3B14FTA	 ZXMN3B14FTC	 ZXMN3F30FHHTA	 ZXMN3F318DN8TA	 ZXMN3F31DN8
 ZXMN3F31DN8TA	 ZXMN3F31DN8TC	 ZXMN3G32DN8	 ZXMN3G32DN8TA	 ZXMN3G32DN8TC
 ZXMN4A06G	 ZXMN4A06GQ	 ZXMN4A06GQTA	 ZXMN4A06GTA	 ZXMN4A06GTC
 ZXMN4A06K	 ZXMN4A06KTC	 ZXMN4A16GTA	 ZXMN61N02FTA	 ZXMN62N02E6TA

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited